

# 低周波~2.5 GHz の TruPwr<sup>™</sup>検出器

# AD8361

### 特長

校正済みの rms 応答 優れた温度安定性 2.5 GHz で最大 30 dB の入力範囲 最大入力: 700 mV rms、10 dBm(50 Ω) 2.5 GHz まで±0.25 dB のリニア応答 単電源動作: 2.7 V~5.5 V 低消費電力: 3 V 電源で 3.3 mW 1 μA 以下への急速なパワーダウン

### アプリケーション

CDMA、W-CDMA、QAM、その他の複素数変調波形の測定 RF トランスミッタ/レシーバ電力の計測

### 概要

AD8361 は、2.5 GHz までの高周波レシーバとトランスミッタ・ シグナル・チェーンを対象とする平均値応答のパワー検出器で す。このデバイスは非常に使い安く、大部分のアプリケーショ ンでは、2.7 V~5.5 V の単電源、電源デカップリング・コンデ ンサ、入力結合コンデンサだけが必要です。出力は、変換ゲイ ン 7.5 V/V ms でリニア応答する DC 電圧です。外付けのフィル タ・コンデンサを追加して平均処理時定数を大きくすることが できます。



### 機能ブロック図



AD8361 は、シンプルな波形と不雑な波形のパワー測定用にデ ザインされています。このデバイスは、CDMA や W-CDMA の ような波高率(rms に対するピーク値の比)の大きい信号に対して 特に有効です。

AD8361 は、さまざまな A/D コンバータ条件に対応するため次の3つの動作モードを持っています。

- 1. グラウンド・リファレンス・モード、基準点がゼロ。
- 内部リファレンス・モード、出力をグラウンドより 350 mV上にオフセット。
- 3. 電源リファレンス・モード、出力を Vs/7.5 にオフセット。

AD8361 の動作は-40°C~+85°C で規定され、8 ピン MSOP また は 6 ピン SOT-23 パッケージを採用しています。このデバイスは、 当社独自の高  $f_T$  シリコン・バイポーラ・プロセスで製造されて います。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に 関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、 アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様 は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。 ※日本語データシートは REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。 ©2004 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

アナログ・デバイセズ株式会社

本 社/〒105-6891 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル 電話 03 (5402) 8200 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー 電話 06 (6350) 6868

# 目次

仕様	3
絶対最大定格	4
ESDに関する注意	4
ピン配置およびピン機能説明	5
代表的な性能特性	6
回路説明	. 11

## 改訂履歴

### 8/04—Data Sheet Changed from Rev. B to Rev. C.

Changed Trimpots to Trimmable Potentiometers	Universal
Changes to Specifications	3
Changed Using the AD8361 Section Title to Applications	12
Changes to Figure 43	14
Changes to Ordering Guide	24
Updated Outline Dimensions	

2/01—Data Sheet Changed from Rev. A to Rev. B.

アプリケーション	12
出力リファレンスの温度ドリフト補償	16
評価ボード	21
キャラクタライゼーションのセットアップ	23
外形寸法	24
オーダー・ガイド	24

## 仕様

特に指定がない限り、T<sub>A</sub>=25°C、V<sub>S</sub>=3 V、 $f_{RF}$ =900 MHz、グラウンド・リファレンス出力モード。

#### 表 1.

Parameter	Condition	Min	Тур	Max	Unit
SIGNAL INPUT INTERFACE	(Input RFIN)				
Frequency Range <sup>1</sup>				2.5	GHz
Linear Response Upper Limit	$V_{\rm S} = 3 V$		390		mV rms
	Equivalent dBm, re 50 $\Omega$		4.9		dBm
	$V_{\rm S} = 5 V$		660		mV rms
	Equivalent dBm, re 50 $\Omega$		9.4		dBm
Input Impedance <sup>2</sup>			225  1		$\Omega \  pF$
RMS CONVERSION	(Input RFIN to Output V rms)				
Conversion Gain			7.5		V/V rms
	$f_{RF} = 100 \text{ MHz}, V_S = 5 \text{ V}$	6.5		8.5	V/V rms
Dynamic Range	Error Referred to Best Fit Line <sup>3</sup>				
$\pm 0.25 \text{ dB Error}^4$	CW Input, $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$		14		dB
±1 dB Error	CW Input, $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$		23		dB
±2 dB Error	CW Input, $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$		26		dB
	CW Input, $V_S = 5 V$ , $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$		30		dB
Intercept-Induced Dynamic	Internal Reference Mode		1		dB
Range Reduction <sup>5, 6</sup>	Supply Reference Mode, $V_s = 3.0 V$		1		dB
	Supply Reference Mode, $V_s = 5.0 V$		1.5		dB
Deviation from CW Response	5.5 dB Peak-to-Average Ratio (IS95 Reverse Link)		0.2		dB
	12 dB Peak-to-Average Ratio (W-CDMA 4 Channels)		1.0		dB
	18 dB Peak-to-Average Ratio (W-CDMA 15 Channels)		1.2		dB
OUTPUT INTERCEPT <sup>5</sup>	Inferred from Best Fit Line <sup>3</sup>				
Ground Reference Mode (GRM)	0 V at SREF, V <sub>s</sub> at IREF		0		V
	$f_{RF} = 100 \text{ MHz}, V_S = 5 \text{ V}$	-50		+150	mV
Internal Reference Mode (IRM)	0 V at SREF, IREF Open		350		mV
	$f_{RF} = 100 \text{ MHz}, V_S = 5 \text{ V}$	300		500	mV
Supply Reference Mode (SRM)	3 V at IREF, 3 V at SREF		400		mV
	V <sub>s</sub> at IREF, V <sub>s</sub> at SREF		V <sub>s</sub> /7.5		V
	$f_{RF} = 100 \text{ MHz}, V_S = 5 \text{ V}$	590		750	mV
POWER-DOWN INTERFACE					
PWDN HI Threshold	$2.7 \le V_S \le 5.5 \text{ V}, -40^{\circ}\text{C} < T_A < +85^{\circ}\text{C}$	$V_{\rm S} - 0.5$			V
PWDN LO Threshold	$2.7 \le V_S \le 5.5 \text{ V}, -40^{\circ}\text{C} < T_A < +85^{\circ}\text{C}$			0.1	V
Power-Up Response Time	2 pF at FLTR Pin, 224 mV rms at RFIN		5		μs
	100 nF at FLTR Pin, 224 mV rms at RFIN		320		μs
PWDN Bias Current			<1		μΑ
POWER SUPPLIES					
Operating Range	$-40^{\circ}C < T_{A} < +85^{\circ}C$	2.7		5.5	V
Quiescent Current	0 mV rms at RFIN, PWDN Input LO <sup>7</sup>		1.1		mA
Power-Down Current	GRM or IRM, 0 mV rms at RFIN, PWDN Input HI		<1		μΑ
	SRM, 0 mV rms at RFIN, PWDN Input HI		$10 \times V_S$		μA

1任意の低周波数での動作が可能です。アプリケーションのセクションを参照してください。

<sup>2</sup>図 17 と図 47 に、それぞれ MSOP と SOT-23 に対するインピーダンスの周波数特性を示します。

3直線領域を使って計算。

<sup>5</sup> SOT-23-6L はグラウンド・リファレンス・モードでのみ動作。 <sup>6</sup> 有効出力振幅したがってダイナミック・レンジは、電源電圧とリファレンス・モードにより変わります。図 39 と図 40 を参照してください。

7電源電流は入力レベルに依存します。図16を参照してください。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>出力リファレンス温度ドリフトを補償。アプリケーションのセクションを参照してください。

# 絶対最大定格

表 2.

Parameter	Rating
Supply Voltage Vs	5.5 V
SREF, PWDN	0 V, V <sub>S</sub>
IREF	$V_{\rm S} - 0.3 V, V_{\rm S}$
RFIN	1 V rms
Equivalent Power, re 50 $\Omega$	13 dBm
Internal Power Dissipation <sup>1</sup>	200 mW
6-Lead SOT-23	170 mW
8-Lead MSOP	200 mW
Maximum Junction Temperature	125°C
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature Range (Soldering 60 sec)	300°C

1デバイスの使用は自然空冷で規定。

 $6 \vdash^{\circ} \succ \text{SOT-23: } \theta_{JA} = 230^{\circ}\text{C/W}; \ \theta_{JC} = 92^{\circ}\text{C/W}_{\circ}$ 

8  $\vdash^{\circ}$  MSOP:  $\theta_{JA} = 200^{\circ}C/W$ ;  $\theta_{JC} = 44^{\circ}C/W_{\circ}$ 

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒 久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格 の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作のセクシ ョンに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものでは ありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバ イスの信頼性に影響を与えます。

### ESDに関する注意



ESD(静電放電)の影響を受けやすいデバイスです。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電する ことがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静 電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する 適切な予防措置を講じることをお勧めします。

# ピン配置およびピン機能説明

VPOS 1		8 SREF		
IREF 2	AD8361	7 VRMS		
RFIN 3 T	OP VIEW	6 FLTR	004	
	ot to Scale)	5 СОММ	1088-0	
図 4.8 ピン MSOP				



#### 表 3.ピン機能の説明

ピン番号 MSOP	ピン番号 SOT-23	記号	説明
1	6	VPOS	電源電圧ピン。動作範囲 2.7 V~5.5 V。
2	_	IREF	出力リファレンス・コントロール・ピン。このピンが解放の場合は内部リファレンス・モードがイネーブ ルされます。その他の場合は、このピンを VPOS に接続しておく必要があります。このピンは、グラウン ドに接続しないでください。
3	5	RFIN	信号入力ピン。AC 結合のソースから駆動する必要があります。低周波実入力インピーダンスは 225 Ω で す。
4	4	PWDN	パワーダウン・ピン。デバイスが検出器として動作する場合、ロー・レベル入力(100 mV 以下)が必要で す。ハイ・レベル(Vs-0.5 V 以上)を入力すると、デバイスがターンオフして、電源電流がほぼゼロになり ます(グラウンドおよび内部リファレンス・モード: 1 μA 以下、電源リファレンス・モード: Vs ÷100 kΩ)。
5	2	COMM	デバイスのグラウンド・ピン。
6	3	FLTR	このピンと VPOS の間にコンデンサを接続すると、変調フィルタのコーナー周波数を低くすることができ ます。内蔵フィルタは、小入力信号に対して 27 pF  2 kΩで構成されます。
7	1	VRMS	出力ピン。限定された電流駆動能力を持つほぼレール to レールの電圧出力。負荷は 10 kΩ (グラウンドへ接 続)以上を想定。
8	—	SREF	電源リファレンス・コントロール・ピン。電源リファレンス・モードをイネーブルするときは、このピン を VPOS に接続します。その他の場合は、COMM (グラウンド)へ接続します。



図 6.入力レベル対出力、周波数 100 MHz、900 MHz、 1900 MHz、2500 MHz、電源 2.7 V、 グラウンド・リファレンス・モード、MSOP



図 7.入力レベル対出力、 電源 2.7 V、3.0 V、5.0 V、5.5 V、周波数 900 MHz



図 8.入力レベル対出力 差動波形の正弦波(CW)、IS95 リバース・リンク、 W-CDMA 4-チャンネルおよび W-CDMA 15-チャンネル、 電源 5.0 V



図 9.入力レベル対リニア・リファレンス電圧からの誤差 片側の平均値に対して 3 シグマ 正弦波、電源 3.0 V、周波数 900 MHz



図 10.入力レベル対リニア・リファレンス電圧からの誤差 片側の平均値に対して3シグマ 正弦波、電源5.0V、周波数900 MHz



図 11.入力対 CW リニア・リファレンス電圧からの誤差 差動波形の正弦波(CW)、IS95 リバース・リンク、 W-CDMA 4-チャンネルおよび W-CDMA 15 チャンネル 電源 3.0 V、周波数 900 MHz



図 12.入力対 CW リニア・リファレンス電圧からの誤差 片側の平均値に対して 3 シグマ、IS95 リバース・リンク信号 電源 3.0 V、周波数 900 MHz



図 13.入力レベル対 CW リニア・リファレンス電圧からの誤差 片側の平均値に対して 3 シグマ、IS95 リバース・リンク信号 電源 5.0 V、周波数 900 MHz







図 15.入力レベル対+25°C からの出力差 片側の平均値に対して 3 シグマ、正弦波、電源 3.0 V、周波数 1,900 MHz、温度-40°C~+85°C



図 16.入力レベル対電源電流、電源 3.0 V、5.0 V、 温度-40°C、+25°C、+85°C



図 17.入力インピーダンスの周波数特性、電源 3 V、 温度-40°C、+25°C、+85°C、MSOP (SOT-23 データは アプリケーション参照)



	GA <sup>-</sup> 900	te pui MHz R	SE FO	DR	-					
	F				370	mV	50 VI D	)0 EF	mV PE RTICAL ISION	R
++++				++++	270 RF IN	mV +++++ NPUT	Į.	+		
					67	mV	Ţ	·		
	<u> </u>				25	mV	$\mathbb{Z}$	/		
		<b>5</b> μs	PERH	IORIZ		DIVIS	ION			

図 24.さまざまな RF 入力レベルでの 変調パルス入力に対する出力応答 電源 3 V、変調周波数 900 MHz、フィルタ・コンデンサなし

01088-C-024



図 25.さまざまな RF 入力レベルでの 変調パルス入力に対する出力応答 電源 3 V、変調周波数 900 MHz、フィルタ・コンデンサ 0.01 µF



図 26.変調パルス入力に対する出力応答用の ハードウェア構成



図 27.さまざまな RF 入力レベルでの パワーダウン・モードを使った出力応答 電源 3 V、周波数 900 MHz、フィルタ・コンデンサなし



図 28.さまざまな RF 入力レベルでの パワーダウン・モードを使った出力応答 電源 3 V、周波数 900 MHz、フィルタ・コンデンサ 0.01 µF



図 29.パワーダウン・モードを使った出力応答用の ハードウェア構成



図 30.変換ゲイン変化の周波数特性 電源 3 V、グラウンド・リファレンス・モード 周波数 100 MHz~2500 MHz、代表的デバイス







図 32.電源ゲーティングに対する出力応答測定のハードウェア構成



図 33.変換ゲイン分布 周波数 100 MHz、電源 5 V、サンプル・サイズ 3000



図 34.出力リファレンス 内部リファレンス・モード、電源 5 V、 サンプル・サイズ 3000 (MSOP の場合)



図 35.出力リファレンス 電源リファレンス・モード、電源 5 V、 サンプル・サイズ 3000 (MSOP の場合)

## 回路説明

AD8361 は、基本的に波形に依存しない RF パワー計測方法を提供する rms に応答する(平均電力)検出器です。この機能は、高 ゲイン誤差アンプの動作により 2 つの同じ 2 乗セルの出力をバ ランスさせる当社独自の技術を使って実現されています。

被測定信号は最初の2 乗セルに入力され、この信号の公称(LF) 抵抗は RFIN ピンと COMM ピン(グラウンド・プレーンに接続) との間で225Ωになります。入力ピンはグラウンドより約0.8 V 高いバイアス電圧にあるため、結合コンデンサが必要です。こ れを外付け部品にすることにより、計測範囲を任意の低い周波 数まで拡張することができます。

AD8361 は入力に与えられた電圧 $V_N$ に応答し、この電圧を 2 乗 して $V_N$ の 2 乗に比例する電流を発生します。この電圧は内部負 荷抵抗に加えられます。この抵抗には並列にコンデンサが接続 されています。これらによりローパス・フィルタが形成され、 これにより $V_N$ の 2 乗平均が発生されます。本質的には電圧に応 答しますが、対応する入力インピーダンスにより、等価電力の 意味でこのポートが校正されます。したがって、1 mWは 447 mV rmsの電圧入力に対応します。アプリケーションのセクショ ンに、この入力を 50  $\Omega$ にマッチングさせる方法を示します。

ローパス・フィルタの電圧(任意の低い周波数が可能)は、誤差 検出アンプの1つの入力に加えられます。2つ目の同じ電圧2 乗セルを使って、この誤差アンプに対する負帰還ループを形成 します。この2つ目のセルは、AD8361の疑似 DC 出力電圧の一 部から駆動されます。2つ目の2乗セルの入力電圧が $V_{IN}$ の rms 値に一致すると、ループが安定状態になり、出力が入力の rms 値を表すようになります。帰還比は公称 0.133 で、次式のよう に rms-dc 変換ゲインは7.5 になります。

 $V_{OUT} = 7.5 \times V_{IN} rms$ 

帰還パスを2つ目の2乗セル(被測定信号の入力に使用したもの と同じ)まで完成させることにより、幾つかの利点が生じます。 1つ目は、これらのセル内のスケーリング効果が相殺されるた めに、2乗セルのオープン・ループ応答を別々に取得しなくと も、全体のキャリブレーションが正確になることです。rms-dc 変換では、クローズド・ループ・スケーリングにリファレンス 電圧が入力されないことに注意してください。2つ目の利点は、 2個のセルの応答は温度に対して良く一致するため、優れたキ ャリブレーションの安定性が得られることです。 2 乗セルは、DC からマイクロ波まで固有な応答を持つ非常に広 い帯域幅を持っていますが、このようなシステムのダイナミッ ク・レンジは、2 乗セル出力でのダイナミック・レンジがはる かに大きくなるために、小さくなってしまいます。ダイナミッ ク・レンジの下端で非常に小さい誤差信号を検出する精度には 実用的な限界があります。これは、小さい入力での精度を制限す る小さいランダム・オフセットがあるためです。

これに対して、AD8361の2乗セルにはAB級の性質があります。 ピーク入力は静止バイアス条件により制限されずに、主に2乗 則に従う損失により制限されます。したがって、応答レンジの 上限は非常に大きな入力レベル(約700 mV rms)となると同時に、 適切な2乗則応答を維持しています。実際、最大有効レンジは 出力振幅により制限されます。レール to レールの出力ステージ では、グラウンドより数 mV 上から電源の100 mV 下まで変化 することができます。出力により発生する制限の例として、ゲ イン=7.5、最大出力=2.9 V、電源電圧=3 V のとき、最大入力は (2.9 V rms)/7.5、すなわち 390 mV rms になります。

#### フィルタ機能

rms-dc 変換で重要点は、平均処理(2 *乗平均*の関数)が必要となる ことです。CDMA の場合のような複素 RF 波形では、内蔵のフ ィルタ機能(ローパス・フィルタ)は 100 MHz 以上の CW 信号に 対しては十分ですが、信号に kHz 領域まで広がる変調成分があ る場合は不十分です。このために FLTR ピンが設けてあります。 このピンと VPOS ピンとの間にコンデンサを接続すると、平均 処理時間を非常に低い周波数まで広げることができます。

#### オフセット

出力にオフセット電圧を加えると(MSOP バージョン使用時)、グ ラウンドまで到達しないレンジを持つ ADC を使うことができる ようになりますが、下端での精度が低下します。これはこの加 えた電圧に元々存在する誤差のためです。この場合には、IREF (*内部リファレンス*)ピンを VPOS に、SREF (*電源リファレンス*) をグラウンドに、それぞれ接続する必要があります。

IREF モードでは、内部リファレンス・セルによりインターセプ トを発生し、インターセプトは電源電圧に無関係な固定の 350 mV になります。このインターセプトをイネーブルするときは、 IREF を解放にし、SREF をグラウンドに接続する必要がありま す。

SREF モードでは、電圧は電源から供給されます。このモードに するときは、IREF を VPOS に、SREF を VPOS に、それぞれ接 続します。そうすると、オフセットは電源電圧に比例し、3 V 電源では 400 mV に、5 V 電源では 667 mV に、それぞれなりま す。

# アプリケーション

#### 基本接続

図 36~図 38 に、AD8361 のMSOPバージョンを 3 つの動作モー ドで動作させるときの基本接続を示します。すべてのモードで、 デバイスは 2.7 V~5.5 Vの単電源を使用しています。VPOSピン は 100 pFと 0.01  $\mu$ Fのコンデンサでデカップリングされています。 動作モードでの 1.1 mAの静止電流は、PWDNピンをVPOSにプ ルアップすると、1  $\mu$ Aに削減することができます。

75 Ωの外付けシャント抵抗と AC 結合入力の組み合わせにより、 全体の広帯域入力インピーダンスが約 50 Ωになります。結合コ ンデンサは入力とシャント・インピーダンスの間に接続する必 要があることに注意してください。入力インピーダンスと入力 結合については、次に詳しく説明します。

入力結合コンデンサと内部入力抵抗(図 37)の組み合わせにより、 次式のようにハイパス・コーナー周波数が求まります。

$$f_{3 \text{ dB}} = \frac{1}{2 \pi \times C_C \times R_{IN}}$$

1

図 36~図 38 に示す 100 pFのコンデンサにより、ハイパス・コー ナー周波数は約 8 MHzになります。





出力電圧は、入力rms電圧の公称 7.5 倍です(変換ゲイン=7.5 V/V rms)。3 つの動作モードは、SREFピンとIREFピンを使って設定します。図 36 に示すグラウンド・リファレンス・モードでは、出力電圧がグラウンド付近から 5.0 V電源で 4.9 Vまで変化しますが、この他に 2 つのモードがあり、オフセット電圧を出力に加えることができます。内部リファレンス・モード(図 37)では、出力電圧振幅が 350 mVの内部リファレンス電圧により上方へシフトされます。電源リファレンス・モード(図 38)では、Vs/7.5 のオフセット電圧が出力電圧に加えられます。表 4 に、接続、出力伝達関数、各モードの最小出力電圧(すなわちゼロ信号)をまとめて示します。

#### 出力振幅

図 39 に、3 つのモードについて 5 V電源電圧に対するAD8361 の 出力振幅を示します。図 39 から、内部リファレンス・モードま たは電源リファレンス・モードでデバイスを動作させると、出 カヘッドルームが小さくなるため、実効ダイナミック・レンジ が小さくなることが分かります。低い電源電圧での応答は同じ ですが(電源リファレンス・モードでは、オフセットが小さい)、 ヘッドルームが減少するため、ダイナミック・レンジがさらに 狭くなります。図 40 に、種々の電源電圧でのCW入力に対する AD8361 の応答を示します。





#### ダイナミック・レンジ

AD8361 は公称伝達関数 7.5 V/V rmsを持つリニア応答デバイス であるため、dBで表すダイナミック・レンジは、図 39 のよう なプロットから明確になりません。入力レベルは一定のdBステ ップで増加すると、出力ステップ・サイズ(dB)も増加します。 図 41 に、出力ステップ・サイズ(mV/dB)と公称伝達関数 7.5 V/V rmsに対する入力電圧との関係を示します。

表4.グラウンド、内	部、電源の各リ	ファレンス・モ	ミードでの接
続と公称伝達関数			

			Output	
Reference			Intercept	
Mode	IREF	SREF	(No Signal)	Output
Ground	VPOS	COMM	Zero	7.5 V <sub>IN</sub>
Internal	OPEN	COMM	0.350 V	$7.5 V_{IN} + 0.350 V$
Supply	VPOS	VPOS	V <sub>s</sub> /7.5	$7.5 V_{IN} + V_S/7.5$



出力電圧対入力電圧のプロットは直線になります。図 42 に示す ようにログ・スケールで誤差をプロットすると、有効なことが あります。理論直線特性のプロットからの乖離は、上端では出 カクリッピングにより、下端では信号オフセットにより、それ ぞれ発生します。ただし、下端でのオフセットは正または負で あることができるため、このプロットは下端で上向きになる傾 向があることに注意する必要があります。図 9、図 10、図 12、 図 13 に、多数のデバイスでのデバイス誤差の±3 シグマ分布を 示します。



また、周波数が高くなると、誤差プロットが右へシフトする傾向があることも図42から明らかです。周波数とともに入力インピーダンスが減少するため、入力に実際に加えられる電圧も減少する傾向があります(周波数に対してソース・インピーダンスが一定の場合)。ダイナミック・レンジは周波数に対してほぼ一定ですが、高周波で変換ゲインが少し減少します。

#### 入力結合とマッチング

周波数が高くなると、AD8361の入力インピーダンスの抵抗成分 と容量成分は減少します(図17)。抵抗成分は、100 MHzでの225 Ωから2.5 GHzでの約95 Ωに変化します。

入力整合には多くのオプションがあります。複数の周波数での 動作に対して、図43に示すグラウンドへの75 Ωシャント抵抗が 最適なマッチングを与えます。1つの周波数での使用に対しては、 抵抗マッチングまたはリアクタンス・マッチングを使うことが できます。スミス・チャートに入力インピーダンスをプロット、 抵抗マッチングの最適値を計算することができます。入力イン ピーダンスがデバイス毎に変わっても1 GHzまでの周波数では VSWRを1.5より小さく維持することができます(入力インピーダ ンスと入力容量は公称値を中心に最大±20%変化することがあり ます)。非常に高い周波数(1.8 GHz~2.5 GHz)で、VSWRを1.5よ り小さくするためには、シャント抵抗は不十分です。VSWRが クリティカルな場合は、シャント成分を除去して、図44に示す ように結合コンデンサと直列にインダクタを挿入します。

表5 に、種々の周波数に対する推奨シャント抵抗値と高い周波数に対する直列インダクタ値を示します。結合コンデンサCcは、 AC短絡として機能するため、マッチングの部分として役立ちま せん。



表 5.抵抗性または誘導性入力マッチングに対する推奨部品値(図 43 と 図 44)

Matching Component
63.4 Ω Shunt
75 Ω Shunt
75 $\Omega$ Shunt
150 Ω Shunt or 4.7 nH Series
150 Ω Shunt or 4.7 nH Series
150 Ω Shunt or 2.7 nH Series

あるいは、図 45 に示すように、グラウンドへ接続するシャン ト・インダクタと直列コンデンサを使ってリアクタンス・マッ チングを実現することもできます。適切なマッチング部品の計 算方法を AD8306 データ・シートの 12 ページに示します。

この方法によるマッチングでは、特に高い周波数でC<sub>M</sub>の値が 非常に小さくなります。そのため、1 pF 程度の小さい漂遊容量 でマッチング品質が大幅に低下することがあります。リアクタ ンス・マッチングの主な利点は感度の増加で、これはマッチン グ回路により入力電圧が(インピーダンス比の平方根だけ)増幅 されることにより発生します。に、リアクタンス・マッチング の推奨値を示します。

表 6.リアクタンス入力マッチングの推奨値(図 45)

Frequency (MHz)	C <sub>M</sub> (pF)	$L_{M}(nH)$
100	16	180
800	2	15
900	2	12
1800	1.5	4.7
1900	1.5	4.7
2500	1.5	3.3

#### 直列抵抗による入力結合

図 46 に、AD8361 への入力信号を結合する方法を示します。こ の方法は、AD8361 の入力範囲に比べて入力信号が大きいとき に使うことができます。直列抵抗とAD8361 の入力インピーダ ンスの組み合わせにより、入力信号が減衰させられます。この 直列抵抗が周波数に依存する入力インピーダンスを持つ分圧器 を構成するため、皮相ゲインが周波数とともに大幅に変わりま すが、この方法には、RFパワー伝送アプリケーションから取り 出されるパワーが非常に小さいという利点があります。抵抗が 伝送線インピーダンスに比べて大きい場合、システムのVSWR への影響は比較的小さくなります。



#### フィルタ・コンデンサの選択

AD8361 の内蔵 27 pF フィルタ・コンデンサは、小信号での 2 k $\Omega$ から大信号での 500  $\Omega$ まで信号レベルにより変化する内部抵抗と並列に接続されます。これから得られる 3 MHz~12 MHz の ローパス・コーナー周波数は、240 MHz (2 乗器出力周波数の 10 倍で、入力周波数の 2 倍)以上のすべての周波数に対して十分な フィルタ機能を提供しますが、CDMA 信号や W-CDMA 信号の ような平均値対ピーク比が高い信号と低周波成分では、フィル タ機能の追加が必要です。GSM、PDC、PHS などの TDMA 信号 は、正弦波に近いピーク対平均値比を持つため、内蔵フィルタ で十分です。

AD8361 のフィルタ容量は、ピン 6 (FLTR)とVPOSの間にコンデ ンサを接続することにより効果を大きくすることができます。 表7に、高いピーク対平均値比を持つ種々の通信規格に対する コンデンサ値の効果と出力残留リップル(ピークtoピーク値とrms V値)を示します。フィルタ・コンデンサを大きくすると、以下 に説明するようにイネーブル時間とパルス応答時間が大きくな ることに注意してください。

Output

		Output	Residual AC	
Waveform	C <sub>FILT</sub>	V dc	mV p-p	mV rms
IS95 Reverse Link	Open	0.5	550	100
	-	1.0	1000	180
		2.0	2000	360
	0.01 µF	0.5	40	6
		1.0	160	20
		2.0	430	60
	0.1 µF	0.5	20	3
		1.0	40	6
		2.0	110	18
IS95 8-Channel	0.01 µF	0.5	290	40
Forward Link		1.0	975	150
		2.0	2600	430
	0.1 µF	0.5	50	7
		1.0	190	30
		2.0	670	95
W-CDMA 15	0.01 µF	0.5	225	35
Channel		1.0	940	135
		2.0	2500	390
	0.1 µF	0.5	45	6
		1.0	165	25
		2.0	550	80

表7.波形に対する効果と残留 AC に対する CFILT

#### 低周波での動作

AD8361の仕様は最大 2.5 GHz までの動作に対して規定されてい ますが、動作周波数の下限はありません。入力ハイパス・フィ ルタのコーナー周波数を下げるためには、入力結合コンデンサ を大きくするだけで済みます(100 MHz 以下の周波数に対しては 225 Ωの入力抵抗を使用してください)。2 乗回路出力の信号か らリップルを除去するために、フィルタ・コンデンサを大きく することも必要です。コーナー周波数は、2 kΩの内部抵抗と外 付けフィルタ容量の組み合わせにより設定されます。

### 消費電力、イネーブル、パワーオン

AD8361の静止消費電流は、入力信号の大きさにより、信号なし の約1 mAから0.66 V rms (9.4 dBm、50 Ω)の入力レベルで7 mAま で変化します。入力がこのポイントを超えて駆動されると、電 源電流が急速に増加します(図16参照)。電源電圧に対して静止 電流が少し変化します。

PWDN (ピン 4)をVPOSに接続するか、デバイスの電源をターン オフすることにより、AD8361 をディスエーブルすることがで きます。デバイスをターンオフすると明らかに消費電流をなく することができますが、デバイスをディスエーブルすると、リ ーク電流を1 µA以下にすることができます。図 27 と 図 28 に、 それぞれ容量なしと 0.01 μFのフィルタ容量を使用した場合につ いて、PWDNピンのパルスに対するAD8361の出力応答を示しま す。ターンオン時間はフィルタ・コンデンサの関数になります。 図 31 に、0.01 µFのフィルタ・コンデンサを使用し、電源をター ンオン(PWDNをグラウンドに接続し、VPOSにパルスを入力)し たときの出力応答のプロットを示します。この場合も、ターン オン時間はフィルタ・コンデンサのサイズにより大きな影響を 受けます。

デバイスのディスエーブル(PWDN = VPOS)中に AD8361 入力を 駆動すると、1 µA 以下のリーク電流は入力レベルの関数として 増加します。デバイスをディスエーブルすると、出力インピー ダンスは約16kΩに増加します。

#### ボルトから dBmへの変換

多くのプロットで、横軸はrms VとdBmで表示されています。す べてのケースで、dBmは50 Ωインピーダンスを基準にして計算 されています。50ΩシステムでdBmとVとの間の変換を行うと きは、次の式を使うことができます。図48に、この変換を図示 します。





図 48.dBm から rms V への変換

#### 出力駆動能力とバッファ機能

AD8361 は、約3 mAの出力電流を供給することができます。さ らに電流が必要な場合は、シンプルなバッファ回路を使うこ - L ができます(図 51 参照)。同じ回路を使って、7.5 V/V rmsの公称 変換ゲインを増減することができます(図 49 と 図 50 参照)。図 50 では、AD8031 は抵抗分圧器をバッファして 3.75 V/V rmsの傾 きを実現しています。図 49 では、オペアンプ・ゲイン=2 によ り、傾きは 15 V/V rmsに増えています。他の抵抗値を使うと、 傾きを任意の値に変えることができます。これらの例で使用さ れたAD8031 レールtoレール・オペアンプは、5 V単電源で 50 mV~4.95 Vの振幅が可能で、2.7 Vまでの低い電源電圧で動作す ることができます。大きな出力電流(>10 mA)が必要な場合は、 レールtoレール機能を持つAD8051 を使うと、3 Vまでの低い電 源電圧で動作することができます。このデバイスは 45 mAまで の出力電流を供給することができます。



図 49.出力バッファ機能オプション、傾き= 15 V/V rms



図 50.出力バッファ機能オプション、傾き= 3.75 V/V rms



図 51.出力バッファ機能オプション、傾き= 7.5 V/V rms

### 出力リファレンスの温度ドリフト補償

AD8361の低温度ドリフトによる誤差は、温度が既知の場合削減 することができます。多くのシステムでは、温度センサーを採 用しています。センサー出力は一般にデジタル化されて、ソフ トウェアによる補正が行われます。この情報を使うと、周囲温 度では2ポイント・キャリブレーションで済みます。

周囲温度(25°C)でのAD8361出力電圧は次式で表すことができま す。

 $V_{OUT} = (GAIN \times V_{IN}) + \zeta_{O\Sigma}$ 

ここで、GAINはV/V rmsで表した変換ゲイン、Vosは0 Vの入力 レベルに対して外挿した出力電圧。GAINとVos (インターセプト と出力リファレンスとも呼ばれます)は、特定の2つの入力レベ ルに対する出力電圧を測定して、シンプルな2ポイント・キャリ ブレーションを使って周囲温度で計算することができます。最 大のリニア・ダイナミック・レンジを得るためには、約35 mV rms (-16 dBm)と250 mV rms (+1 dBm)でのキャリブレーションが 推奨されます。ただし、アプリケーションに合わせて、その他 のレベルとレンジを選択することができます。GAINとVosは、 次式を使って計算します。

$$GAIN = \frac{\left(V_{OUT2} - V_{OUT1}\right)}{V_{IN2} - V_{IN1}}$$

 $V_{OS} = V_{OUT1} - (GAIN \times V_{IN1})$ 

GAINとVosは温度に対してドリフトしますが、Vosのドリフトは、 出力に比べ誤差に対して大きな影響を与えます。これは、図 18 と図 21 のデータ(インターセプト・ドリフトと変換ゲイン)を Vourの式に代入すると明らかになります。これらのプロットは、 図 14 と 図 15 に一致しています。これは、温度ドリフトによる 誤差は、入力レベルの増加とともに減少することを示していま す。これは、オフセット誤差の全体の測定誤差に対する影響が レベルの増加とともに少なくなることに起因しています。

図 18 から、平均インターセプト・ドリフトは-40℃~+25℃で 0.43 mV/℃に、+25℃~+85℃で 0.17 mV/℃にそれぞれなります。 厳密でない補償方式の場合、全温度範囲での平均ドリフトは次 のように計算されます。

$$DRIFT_{VOS}(V/^{\circ}C) = \left(\frac{0.010 V - (-0.028 V)}{+85^{\circ}C - (-40^{\circ}C)}\right) = 0.000304 V/^{\circ}C$$

ドリフトVosを考慮すると、Vourの式は次のようになります。  $V_{OUT} = (GAIN \times V_{IN}) + V_{OS} + DRIFT_{VOS} \times (TEMP - 25^{\circ}C)$ 

V<sub>IN</sub>の温度補償値を求めるために、この式を次のように変形することができます。

$$V_{IN} = \frac{\left(V_{OUT} - V_{OS} - DRIFT_{VOS} \times (TEMP - 25^{\circ}C)\right)}{GAIN}$$

図52 に、出力電圧と誤差(dB)を代表的なデバイスの入力レベル の関数として示します(出力電圧は対数スケールでプロットして あります)。図53に、温度補償アルゴリズムを適用した後の、入 カレベル計算値の誤差を示します。電源電圧=5 Vの場合、この デバイスは35 dBのダイナミック・レンジで温度に対して約 ±0.3dBのワーストケース・リニアリティ誤差を持ちます。



図 52.入力レベル対出力電圧と誤差の typ 値 800 MHz、VPOS = 5 V



図 53.出力リファレンスの温度補償後の誤差 800 MHz、V<sub>POS</sub> = 5 V

#### 周波数拡張のキャラクタライゼーション

AD8361 は本来パワー測定および携帯電話アプリケーションの コントロール・デバイスを対象としていますが、AD8361 は高 い周波数で役立つ性能を持っています。代表的なアプリケーシ ョンとしては、MMDS、LMDS、WLAN、その他の非携帯電話 動作などがあります。

2.5 GHz より高い周波数で AD8361 をキャラクタライズするため、 小数のデバイスをテストしました。−30℃~+80℃ の温度範囲で、 ダイナミック・レンジ、変換ゲイン、出力インターセプトを幾 つかの周波数で測定しました。キャラクタライゼーション・プ ロセスでは変化するピーク対平均値波形性能をアクセスするた めに CW と 64 QAM 変調された入力波形を使いました。

デバイスのダイナミック・レンジは、デバイスが理論伝達関数 に対する許容誤差マージン内に収まる入力電力範囲として計算 しました。デバイスは、周波数と温度に対してテストしました。 与えられたアプリケーションに対する許容誤差マージンを求め た後、図 54~図 57 のプロットを使って有効ダイナミック測定 範囲を求めることができます。例えば、1 dBの誤差マージンと 3 GHzの変調されたキャリアの場合、有効ダイナミック・レン ジは、図 57 の 3 GHzプロットから求めることができます。 -30°Cのカーブは、-1 dBの誤差規定値と-17 dBmで交差するこ とに注意してください。5 V電源の場合、圧縮を避けるために最 大入力電力は 6 dBmを超えることはできません。したがって、 有効ダイナミック・レンジは次のようになります。

#### 6 dBm - (-17 dBm)

あるいは、-30°C~+80°Cの温度範囲で23 dBmになります。



図 54.64 QAM 変調信号に対して 1.5 GHz で測定した 伝達関数と誤差のプロット



図 55.64 QAM 変調信号に対して 2.5 GHz で測定した 伝達関数と誤差のプロット



図 56.64 QAM 変調信号に対して 2.7 GHz で測定した 伝達関数と誤差のプロット



図 57.64 QAM 変調信号に対して 3.0 GHz で測定した 伝達関数と誤差のプロット



図 58.入力駆動レベル対 CW リニア・リファレンスからの誤差 CW と 64 QAM 変調信号、3.0 GHz



図 59.変換ゲインの周波数特性 代表的デバイス、電源3V、グラウンド・リファレンス・モード

CW入力と 64 QAM入力波形に対する伝達関数と誤差を 図 58 に 示します。誤差カーブは、CWデータに基づくリニア・リファ レンスから得ています。64 QAM変調の波高率の増加により、 AD8361 の出力が減少しました。出力のこの減少は、限定され た帯域幅と内部ゲイン・ステージの圧縮に起因しています。こ の不正確さは、波高率が変化する信号を測定するシステムで考 慮する必要があります。

変換ゲインは、入力ms電圧に対する出力電圧の傾きとして求め られます。理論最適合カーブは、与えられた電源電圧と温度で 測定した伝達関数から求めることができます。理論カーブの傾 きは、特定のデバイスの変換ゲインとして決定されます。変換 ゲインは、RF波形のms入力電圧に対するAD8361の測定感度に 関係します。変換ゲインは、多数のデバイスについて-30℃~ +80℃の温度範囲で測定しました。代表的なデバイスの変換ゲ インを 図 59 に示します。変換ゲインは周波数の増加とともに 減少する傾向がありますが、AD8361 は 2.5 GHzより高い周波数 で測定機能を提供します。ただし、高い周波数での変換ゲイン の変化に対応するため与えられたアプリケーションに対してキ ャリブレーションすることが必要です。

#### AD8361 のダイナミック・レンジの拡張

AD8361の正確な測定範囲は、小入力信号に対する内部 DC オフ セットと大信号に対する 2 乗則適合誤差により制限されます。 測定範囲は、異なる信号レベルで動作する 2 個のデバイスを使 い、優勢な入力レベルで正確な結果を与える方のデバイスの出 力のみを選択することにより、拡張することができます。

図 60 に、この考えの実施を示します。この回路では、2 個の AD8361 の伝達関数の不完全な一致の影響を小さくするために、 出力の選択は約 3 dBの入力レベル範囲で徐々に行います。この ような不一致は一般に、RFプリアンプU1 のゲイン変動および 温度による両AD8361 のゲインと傾きの変動のために発生しま す。

一方の AD8361 (U2)はその前までに約 14 dB のネット・ゲイン を持つため、低い入力信号レベルで最も正確に動作します。こ

れは、弱い信号パスと呼ばれます。これに対して U4 は、ゲインの追加がなく、高いレベルで正確な応答を提供します。伝達関数(R1 のスライダから見た)の傾きを U4 自体の傾きと一致させるようにするため U2 の前のゲインの影響を相殺させるために、U2 の出力は R1 により減衰させられます。

U3、U5、U6から構成される回路は一種のクロスフェーダとし て機能し、2つの入力の相対ゲインをQ1とQ2で構成されるフ ァジー・コンパレータの出力電流により徐々に決定します。R2 のスライダが2.5 V dc であるとすると、ファジー・コンパレー タは、U2出力が約2.0 V dcより低いとき弱い信号パスをフルに 選択し、U3出力が約3.0 V dcを超えたとき強い信号パスをフル 選択するように指示します。U3とU5はOTA (相互コンダクタ ンス・オペ・アンプ)です。



U6 は、OTA に固有な tanh 伝達関数を直線化する帰還を提供し ます。OTA の一方がフル選択されたとき、帰還が非常に有効に 機能します。アクティブな OTA はゼロの差動入力を持ち、非ア クティブな OTA は大きな差動入力を持つ可能性がありますが、 非アクティブな OTA は出力に影響しないのでこれは問題になり ません。ただし、両 OTA がある程度アクティブになり、かつク ロスフェーダへの2つの信号入力が異なる場合、両 OTA がゼロ 差動入力を持つことが不可能になります。この場合、OTA の非 直線的な伝達関数のため、クロスフェーダは明らかに歪みを発 生します。幸いなことに、このアプリケーションでは、歪みは 次の2つの理由で大きな問題にはなりません。

- クロスフェーダへの入力レベルの不一致は、非常に大きな 歪みを発生するほど大きくなることはありません。これは、
   AD8361の適切な動作によります。
- この場合の歪みの影響は、クロスフェーダの2つの入力間 での変化のほぼ直線的であった傾きに歪みを与えるだけで す。



この回路には、調節可能なポテンショメータが 3 個あります。 推奨セットアップ手順を次に示します。

- 1. R3をミッドレンジに予め設定します。
- スライダの電圧が変化領域の中心になるように R2 を設定 します(約 2.5 V DC を推奨)。
- 伝達関数の傾きが変化領域の両側で一致するようにR1を設定します。この作業は、変化領域の両側間で傾きの一致度を知るために伝達関数全体のプロット(両軸でリニア電圧スケールを使用)を作成することにより最も能率よく行うことができます(図 61 参照)。注:傾きの差を正確に読み取るために、R3を調節して伝達関数の大きなずれを除去することが便利です。
- 4. 最後に、必要に応じてR3を際調節して伝達関数の残っているずれを除去します(図62参照)。



原理的に、この方法は測定範囲をさらに広げるために 3 個以上 の AD8361 に拡張することができます。ただし、強い信号条件 の下で弱い方の信号パスで AD8361 を過駆動しないように注意 することが非常に重要です。

図 63 に、範囲を拡張した伝達関数を複数の温度に対して示しま す。約 0.2 V msでの不連続は部品の温度依存性から生じます。図 64 に、of the範囲拡張回路の誤差(dB)を周囲温度に対して示します。 1 dBの誤差マージンの場合、範囲拡張回路は 38 dBの測定範囲を 提供します。



# 評価ボード

図65 と図68に、AD8361評価ボードの回路図を示します。未実 装部品は破線で表示してあります。部品面のレイアウトとシル クスクリーンを図66、図67、図69、図70に示します。ボードの 電源は、2.7 V~5.5 V範囲の単電源です。電源は、100 pFと0.01  $\mu$ Fのコンデンサでデカップリングしています。R6での直列抵抗 または直列インダクタとしてデカップリングを追加することも できます。表8に、評価ボードの種々の設定オプションを示しま す。

#### 表8.評価ボードの設定オプション

部品	機能	デフォルト状態
TP1、TP2	グラウンドおよび電源ベクタピン。	Not Applicable
SW1	デバイス・イネーブル。ポジションAのとき、PWDNピンは+Vs接続されて、AD8361はパワーダウン・モードになります。ポジションBのとき、PWDNピンはグラウンドに接続されて、デバイスは動作モードになります。	SW1 = B
SW2/SW3	動作モード。グラウンド・リファレンス・モード、内部リファレンス・モード、電源リファレン ス・モードを選択します。詳細については、表7を参照。	SW2 = A, SW3 = B (Ground Reference Mode)
C1、R2	入力結合。ポジションR2の75Ω抵抗とAD8361の内部入力インピーダンスの組み合わせにより、 約50Ωの広帯域入力インピーダンスを提供します。特定の周波数で正確なマッチングを得るため には、R2を様々な値で置き換えることができます(入力結合とマッチングおよび図43~図46参 照)。	R2 = 75 Ω (Size 0402) C1 = 100 pF (Size 0402)
	コンデンサ C1 により入力信号を AC 結合し、コーナー周波数が約8 MHz のハイパス入力フィルタ を形成します。低周波での動作向けに C1 を大きくすることができます。入力に減衰抵抗が必要な 場合は、直列抵抗 R1 (公称0Ω)を適切な値で置き換えることができます。	
C2、C3、R6	電源デカップリング。公称 0.01 µF と 100 pF の電源デカップリング。R6 の直列インダクタまたは 小さい抵抗を置き換えてデカップリングを強化することもできます。	C2 = $0.01 \ \mu F$ (Size 0402) C3 = $100 \ pF$ (Size 0402) R6 = $0 \ \Omega$ (Size 0402)
C5	フィルタ・コンデンサ。内蔵の 50 pF 平均処理コンデンサは、C5 の容量を変更して効果を大きく することができます。	C5 = 1  nF (Size 0603)
C4、R5	出力負荷。C4 と R5 の抵抗とコンデンサを置き換えて、テスト用 V rms 負荷を与えることができ ます。	C4 = R5 = Open (Size 0603)



評価ボードを使用して AD8361 性能を評価するとき、インピー ダンスの不整合から問題が生ずることがあります。 これらの問 題を少なくする1つの方法は、RFIN SMA コネクタに同軸 3 dB 減衰器を接続することです。ソース、ケーブル、ケーブル接続 での不整合や評価ボード上でのこれらの不整合から、これらの 問題が発生することがあります。

このような問題のシンプルな(さらに一般的な)例は、ソースと 評価ボードでの不整合から発生する 3 回の反射です。この場合、 ソースからの信号が評価ボードに到達し、不整合により反射さ れます。この反射がソースの不整合に到達すると、新しい反射 が発生して、これが評価ボードに戻りボードに入射する元の信 号に加わります。発生する電圧は、ケーブル長と元の信号と反 射信号の相対位相に対する周波数依存性により変化します。ボ ード入力に 3 dB パッドを接続すると、ボードでの整合を改善で きるため、ソース不整合の影響を弱くすることができます。こ のような対策を行うと、測定はケーブル長やその他の治具問題 の影響を受け難くなります。実際のアプリケーションで AD8361 とソースの距離が短く適切な場合には、この 3 dB 減衰 器は不要です。

### キャラクタライゼーションのセットアップ

#### 装置

基本的なキャラクタライゼーション・セットアップを 図 72 に 示します。使用した信号ソースはRohde & Schwarz SMIQ03B、 バージョン 3.90HXです。 IS95 リバース・リンク、IS95 の 9 ア クティブ・チャンネル・フォワード(フォワード・リンク 18 設 定)、W-CDMA 4 チャンネル、15 チャンネルに対して使用した 変調済み波形は、デフォルトの設定コーディングとフィルタリ ングを使って発生しました。信号レベルは 50 Ωインピーダンス でキャリブレーションしました。

#### 解析

変換ゲインと出力リファレンスは、動作範囲の中央(35 mV rms ~250 mV rms)で取得したデータに実行した線形回帰の係数を使って求めました。この範囲は、オフセットによりリニア応答が 歪みを受ける動作領域を避けて選択されました。誤差は、CW 波形に対するリニア応答と2℃性能の出力差から得た2形式で誤 差を表しました。

CW波形に対するリニア応答から得た誤差は、変換ゲインと出 カリファレンスで決定される理論出力の差です。これは、CW 波形と変調済み波形に対するデバイス応答の線形性を表します。 この誤差(dB)では、変換ゲインと入力の積をその基準として使 っています。CW波形に対するリニア応答から得た誤差は、各 デバイスのゲインと出力リファレンスを使って計算しているた め絶対精度を表していません。ただし、デバイス応答に対する 線形性と変調の効果は表しています。25℃性能から得た誤差で は、与えられたデバイスと波形タイプの性能を基準として使っ ています。これは、主に温度に対する出力変動を表しています。



## 外形寸法





COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178AB

図 74.6 ピン・スモール・アウトライン・トランジスタ パッケージ[SOT-23] (RT-6) 寸法: mm

## オーダー・ガイド

	1		1	
Model	Temperature Range	Package Description	Package Option	Branding
AD8361ARM	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, Tube	RM-8	J3A
AD8361ARM-REEL	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, 13" Tape and Reel	RM-8	J3A
AD8361ARM-REEL7	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, 7" Tape and Reel	RM-8	J3A
AD8361ARMZ <sup>1</sup>	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, Tube	RM-8	J3A
AD8361ARMZ-REEL <sup>1</sup>	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, 13" Tape and Reel	RM-8	J3A
AD8361ARMZ-REEL71	-40°C to +85°C	8-Lead MSOP, 7" Tape and Reel	RM-8	J3A
AD8361ART-REEL	-40°C to +85°C	6-Lead SOT-23, 13" Tape and Reel	RT-6	J3A
AD8361ART-REEL7	-40°C to +85°C	6-Lead SOT-23, 7" Tape and Reel	RT-6	J3A
AD8361ARTZ-RL7 <sup>1</sup>	-40°C to +85°C	6-Lead SOT-23, 7" Tape and Reel	RT-6	J3A
AD8361-EVAL		Evaluation Board MSOP		
AD8361ART-EVAL		Evaluation Board SOT-23-6L		

<sup>1</sup>Z=鉛フリー・デバイス